

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-326311

(43)Date of publication of application : 22.11.2001

(51)Int. Cl.

H01L 23/427

F25B 39/02

F25D 9/00

F25D 15/00

(21)Application number : 2000-147452

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing : 15.05.2000

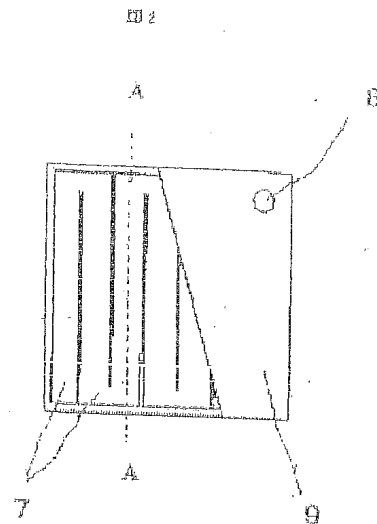
(72)Inventor : ASHIWAKE NORIYUKI
KAWAMURA KEIZO

(54) COOLING DEVICE FOR ELECTRONIC EQUIPMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To relax the limit amount of heat that can be taken by an evaporator in the cooling device of electronic equipment in a system for performing forced flow cooling by mounting the evaporator of a refrigerating machine to a module directly.

SOLUTION: A channel in the evaporator is allowed to have curvature. Also, by providing a fine groove on a channel wall, a liquid film can be retained on the channel wall easily, and the limit amount of heat that can be taken by the evaporator can be relaxed.



(10) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-326311
(P2001-326311A)

(43) 公開日 平成13年11月22日 (2001. 11. 22)

(51) Int. Cl.

H 0 1 L 23/427
F 2 5 B 39/02
P 2 5 D 9/00
15/00

識別記号

F I

P 2 5 B 39/02
F 2 5 D 9/00
15/00
H 0 1 L 23/46

7-427 (参考)

Z 3 L 0 4 4
E 3 L 0 4 5
5 F 0 3 6
A

審査請求 未請求 願求項の数 1 0 L (全 4 頁)

(21) 出願番号

特願2000-147452 (P2000-147452)

(22) 出願日

平成12年5月15日 (2000. 5. 15)

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区柏田豊洞台四丁目6番地

(72) 発明者

菅分 勉之

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(72) 発明者

川村 圭三

茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

(74) 代理人

100075086

弁理士 作田 康夫

(54) 【発明の名称】 電子機器の冷却装置

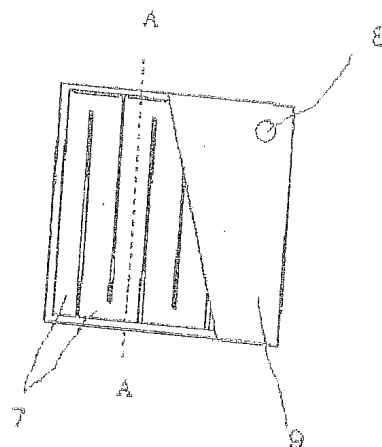
最終頁に続く

(57) 【要約】

【課題】 モジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付けて強制流動冷却する方式の電子機器の冷却装置において、蒸発器で取りうる熱量の限界を引き上げることである。

【解決手段】 上記課題を解決するために本発明では蒸発器内の流路に曲率をもたせた。また流路壁に微細な溝を設け、流路壁上に液膜が保持されやすくなり、蒸発器で取りうる熱量の限界を引き上げることができる。

図2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】半導体チップを搭載したモジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付け付けて冷却する電子機器の冷却装置において、蒸発器の底部を凹面上にし、そこに流路を形成したことを特徴とする電子機器の冷却装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は電子計算機に用いられる半導体素子の冷却技術の分野に属する。冷却すべき半導体素子がCMOS素子である場合には、その性能が温度によって変化することが知られている。CMOS素子では低温化することによって動作速度が速くなるため、チップ面上に形成された素子を低温に保ち、素子の動作を加速することが行われている。

【0002】

【従来の技術】特開平9-139453号公報に垂直に設置された中空容器に冷媒を封入しこの中空容器の下方に半導体素子を圧接機台し冷媒の蒸発によってこの半導体素子を冷却する構造が開示されている。この中空容器の上方には冷却部が設けられ、下方で蒸発した冷媒は冷却部で凝縮し、重力の作用で蒸発部に戻る。即ち冷媒を強制流動せしめる装置は存在せず、自然循環が前提である。本従来技術では、中空容器の加熱部の幅を上方ほど広くする構造が開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】近年のLSIチップにはCMOS素子が用いられ、従来のバイポーラ素子を用いた場合に比べ、発熱量は一旦減少した。しかしながら、素子の高集積度化と動作周波数の増大によって、LSIチップ当たりの発熱量は再び急上昇し始め、このようなLSIチップを搭載したモジュールも大発熱量化しつつある。

【0004】モジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付け付けて強制流動冷却する方式の電子機器の冷却装置は大発熱量のモジュールを低温に冷却するのに適しているが、電子計算機の場合、装填のコンパクト性が強く要求されるため、蒸発器の大きさはモジュールと同程度の大きさに制限される。このような小形の蒸発器で取りうる熱量には蒸騰現象や冷媒の乾きによる限界があると考えられ、モジュールの大発熱量化に対応するためには、この限界を引き上げることが極めて重要な課題となる。

【0005】従来の技術は自然循環蒸発による冷却技術であり、強制流動蒸発による大発熱量のモジュールの冷却方法に関しては配慮されていない。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明では、モジュールに直接取り付け付ける蒸発器の底部を凹面上にし、そこに流路を形成した。また、流路壁に微細な溝を形成した。

【0007】

(2)

特開2001-326311

2

【発明の実施の形態】図1に、半導体チップを搭載したモジュールに冷凍機の蒸発器を直接取り付け付けて冷却する電子機器の冷却装置の構成を示す。蒸発器1、圧縮機2、凝縮器3及び減圧装置4から成る冷凍機の蒸発器1が、半導体チップを搭載したモジュール5に熱伝導グリース6等を介して直接取り付けられる。モジュール5は蒸発器1内で蒸発する冷媒が蒸発潜熱を奪うことにより冷却される。電子計算機の場合、装填のコンパクト性が強く要求されるので、蒸発器の大きさはモジュールと同程度の大きさに制限される。

【0008】図2及び図3に本発明の一実施例をしめす。蒸発器は冷媒を流すための流路7、及び、冷媒を供給、排出するための管8（一方のみ図示）及びカバー9から成る。図3は図2におけるA-A断面図を表している。蒸発器底部10は凹面になっており、そこに流路7が形成されている。即ち、流路7はある大きさの曲率を有している。

【0009】次に本実施例の作用を説明する。冷媒は流路内を蒸発しながら二相流の状態で流れ、蒸発器内の二相流の流動様式は大部分の領域で、流路壁に液膜が存在し中心部を蒸気が流れるいわゆる層状流となる。この場合、特に流路の下流部の蒸気流速の大きい領域で液膜が破断して微細な液滴が蒸気とともに流れる噴霧流が出現しやすくなり、流路壁が乾き、蒸発器の底部の温度が急激に上昇する限界熱流束現象が発生しやすくなり、蒸発器で取りうる熱量に限界が生じる。

【0010】本実施例では、流路7に曲率を持たせたため、二相流に遠心力が作用し、液膜を流路底に押し付ける降下が生じ、液膜が破断しにくくなるため、限界熱流束現象が発生しにくく、蒸発器で取りうる熱量を引き上げることができるという作用効果がある。

【0011】図4に本発明の他の実施例を示す。流路7の壁面上に微細な溝11を形成したものである。本実施例によれば、第1の実施例の遠心力の効果に加えて、表面張力による液膜保持作用があるので、蒸発器で取りうる熱量の限界をさらに引き上げることが可能になる。

【0012】

【発明の効果】本発明では、モジュールに直接取り付けられる蒸発器内の流路に曲率をもたせた。これによって冷媒二相流に遠心力が作用するようにしたから限界熱流束現象が発生しにくく、蒸発器で取りうる熱量の限界を引き上げることができる。また、流路壁面上に微細な溝を形成したから、表面張力が作用し液膜の保持が容易になり、蒸発器で取りうる熱量の限界をさらに引き上げることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例である半導体チップの冷却システムを示す構成図。

【図2】本発明の一実施例の平面図。

【図3】本発明の一実施例の断面図。

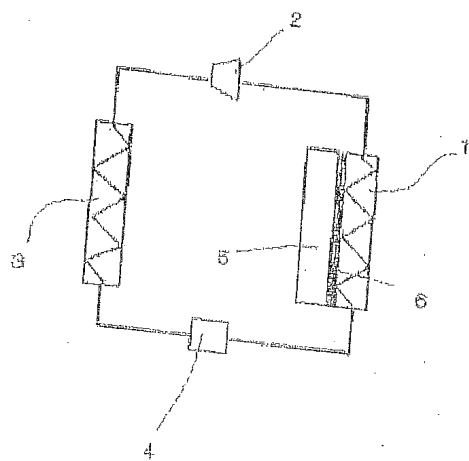
55

【図4】 本発明の他の実施例の断面図。
【符号の説明】

1…蒸発器、2…圧縮機、3…凝縮器、4…減圧装置、5…モジュール、6…熱伝導グリース、7…流路、8…管、9…カバー、10…蒸発器底部、11…微細溝。

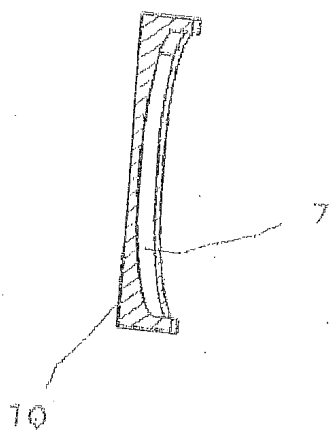
【図1】

図1



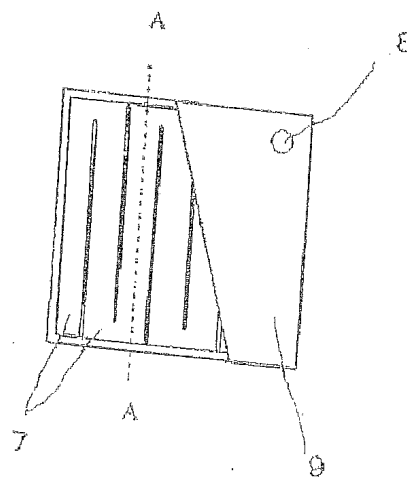
【図3】

図3



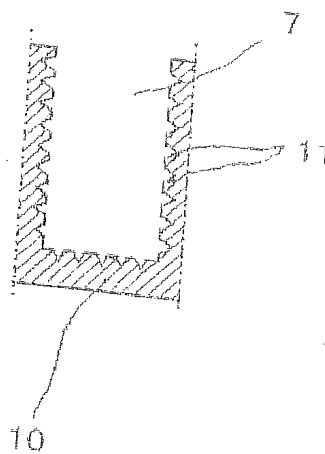
【図2】

図2



【図4】

図4



(4)

フロントページの続き

特開2001-326311

Fターム(参考) 3L044 AA04 BA06 CA14 DD07 FA04
KA04 KA05
3L045 AA04 AA06 BA04 CA02 GA05
HA01 PA04
5F036 AA01 BA08 BA23 BB53